

2907A

硅 PNP 外延平面晶体管芯片 (4 ")

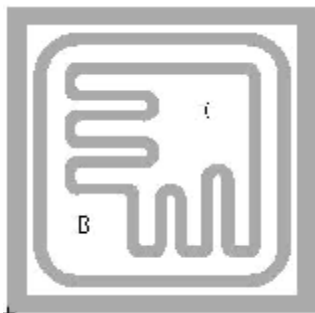
■用途:

*一般用途放大器

■特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 2222A 配对
- *集电极电流:0.6A
- *有效图形数: 33400

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	460 μ m×460 μ m
压焊区尺寸	基 区 110 μ m×110 μ m 发射区 120 μ m×120 μ m
芯片厚度	180±10 μ m
锯片槽宽度	55 μ m
金属层	正面:Al 2.3±0.2 μ m 背面:Au 1.4±0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	典型值	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=-100 \mu A, I_E=0$	-60		-130	V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=-1mA, I_B=0$	-60		-95	V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=-100 \mu A, I_C=0$	-5		-9.0	V
集电极--发射极反向截止电流	I_{CEX}	$V_{CE}=-30V, V_{EB}=-0.5V$		-50		nA
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-50V, I_E=0$		-20		nA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-4V, I_C=0$		-10		nA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-0.1mA$	75			
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-150mA$	100	300		
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-500mA$	50			
特征频率	f_t	$I_C=-20mA, V_{CE}=-50V, f=100MHz$	200			MHz
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$		-1.6	-0.55	V
基极--发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$		-2.6	-0.98	V
延迟时间	t_d	$V_{CC}=-30V, I_C=-150mA$		10		ns
上升时间	t_r	$I_{B1}=-15mA$		25		ns
储存时间	t_s	$V_{CC}=-6V, I_C=-150mA,$		225		ns
下降时间	t_f	$I_{B1}=-I_{B2}=-15mA$		60		ns